

| 頁   | 行・図            | 誤  | 正   |
|-----|----------------|--|---|
| 2   | 図1.1中          | 水溶液中のイオン<br>H <sup>+</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , OH <sup>-</sup><br>影響小 ⇒ 無視   | 水溶液中のイオン<br>H <sup>+</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , OH <sup>-</sup><br>影響小 ⇒ 無視  |
| 5   | 上から2行目         | 反応式で表すことが多い。   | 反応式で表せる。  |
| 13  | 上から2行目         | , といった点であろう。   | , である。  |
| 29  | 下から2行目         | の中で満たされた状態で存在している。   | を満たしている。  |
| 34  | 式(3.3)         | $gG(\nu, T)$   | $qG(\nu, T)$  |
| 46  | 下から1行目         | の温度, $q$ は電子の電荷である。  | の温度である。   |
| 48  | 式(4.20)        | $F_s - F_c(V) + R(0) - R(V)$   | $F_s + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)$   |
|     | 式(4.21)        | $= F_s - F_c(V) + R(0) - R(V)$ $\leftrightarrow I = q\{F_s - F_{c0} + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)\}$ $\leftrightarrow I = q\left\{F_s - F_{c0} + F_{c0} - F_{c0} \exp\left(\frac{V}{V_c}\right) + R(0) - R(0) \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = q(F_s - F_{c0}) + q\{F_{c0} + R(0)\}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = q(F_s - F_{c0}) + \frac{qF_{c0}}{f_c}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ | $= F_s + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)$ $\leftrightarrow I = q\{F_s + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)\}$ $\leftrightarrow I = q\left\{F_s + F_{c0} - F_{c0} \exp\left(\frac{V}{V_c}\right) + R(0) - R(0) \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = qF_s + q\{F_{c0} + R(0)\}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = qF_s + \frac{qF_{c0}}{f_c}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ |
| 49  | 下から9行目         | 無輻射において  | 非輻射において   |
| 50  | 上から7行目         | $F_c$  | $f_c$   |
|     | 上から8行目         | $q(F_s - F_{c0})$  | $qF_s$  |
|     | 下から1行目         | 輻射と非輻射の両方による電子 - 正孔対の再結合が増加することとなり,  | (削除)  |
| 51  | 上から9行目         | $q(F_s - F_{c0})$  | $qF_s$  |
|     | 上から10行目        | 第1項の太陽光エネルギーによって生成された電子-正孔対の数 $F_s$ は, 太陽電池自体の温度 $T_c$ での黒体輻射による電子-正孔対の生成数 $F_{c0}$ よりはるかに大きい, すなわち, $F_s \gg F_{c0}$ なので<br>$q(F_s - F_{c0}) \doteq qF_s$ (4.26)<br>と表される。  | (削除)  |
|     | 下から7行目         | 式(4.26)の近似を用いたうえで,   | (削除)  |
| 52  | 上から12行目        | 無輻射 (2箇所)  | 非輻射 (2箇所)   |
| 58  | 式(4.29)'       | $\exp\left(\frac{V_{op}}{V}\right)$  | $\exp\left(\frac{V_{op}}{V_c}\right)$   |
| 59  | 式(5.7), 式(5.8) | $\left\{\exp\left(\frac{V_{op}}{V_c}\right) - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$  | $\left\{\exp\left(\frac{V_{op}}{V_c}\right) - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$   |
| 77  | 下から1行目         | InGaP/InGaAs/Ge  | InGaP/GaAs/InGaAs   |
| 115 | 上から10行目        | 波長の光が  | 波長 $\lambda$ の光が  |
| 119 | 上から6行目         | (N層膜厚)   | (n層膜厚)  |
| 120 | 上から9行目         | 電子流密度  | 電流密度  |
| 130 | 図8.2           |  |   |
| 141 | 脚注の下から1行目      | エネルギー分散については   | エネルギー分散については  |
| 147 | 下から1行目         | $1.15m_0$  | $0.54m_0$   |
| 148 | 式(8.29)        | $= \sqrt{(2.86 \times 10^{19})(3.01 \times 10^{19})} \exp\left(-\frac{1.124}{2 \times 0.02586}\right)$ $= 1.08 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$   | $= \sqrt{(2.89 \times 10^{19})(1.01 \times 10^{19})} \exp\left(-\frac{1.124}{2 \times 0.02586}\right)$ $= 6.23 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$   |
| 149 | 下から3行目         | $n_0 \doteq 1.2 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$   | $n_0 \doteq 3.9 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$  |
|     | 下から2行目         | 0.21 eV (2箇所)  | 0.18 eV (2箇所)   |
| 150 | 上から8行目         | このように半導体が  | 半導体が  |
| 151 | 上から6行目         | $n_i$ の曲線は真性半導体における電子密度の   | 曲線は真性半導体における電子密度 $n_i$ の  |
|     | 図8.13図説        | N型Si   | n型Si  |

| 頁   | 行・図             | 誤  | 正   |
|-----|-----------------|--|---|
| 154 | 下から13行目         | いずれの場合も電子の有効質量のほうが正孔の有効質量より小さいので、電子の移動度のほうが大きくなる。                                    | いずれの場合も電子の移動度のほうが大きい。   |
| 155 | 式(8.47)         | $\doteq e \frac{l}{2t} \cdot \frac{dn}{dx}$  | $\doteq e \frac{l}{2t} \cdot \frac{dn}{dx} l$                         |
| 156 | 式(8.49), (8.50) | $\frac{kT}{q}$   | $\frac{kT}{e}$  |
| 157 | 上から5行目          | 連続の方程式   | <b>連続の方程式</b>   |
| 160 | 上から12行目         | 非平衡化での   | 非平衡下での  |
| 165 | 式(8.76)         | $= \left[ E_g - kT \left( \ln \frac{N_C}{N_D} + \ln \frac{N_V}{N_A} \right) \right]$ | $= E_g - kT \left( \ln \frac{N_C}{N_D} + \ln \frac{N_V}{N_A} \right)$ |
| 166 | 式(8.81)         | $-\frac{qN_D}{2\epsilon} \quad x_N \leq x \leq x_0$                                  | $-\frac{eN_D}{2\epsilon} \quad x_N \leq x \leq x_j$                   |
|     | 式(8.82)         | $x_0 \leq x \leq x_P$  | $x_j \leq x \leq x_P$   |
| 169 | 上から9行目          | $\Delta n_N(x_N)$  | $\Delta p_N(x_N)$   |
| 177 | 索引              | 連続の方程式 116   | 連続の方程式 116, 157   |

最新の正誤表がコロナ社ホームページにある場合がございます。

①

下記URLにアクセスして[キーワード検索]に書名を入力して下さい。

<http://www.coronasha.co.jp>